PASJ2020 THPP51

グリッド付き熱カソードを用いた低エミッタンス電子銃システム LOW-EMITTANCE ELECTRON GUN SYSTEM WITH GRIDDED THERMIONIC-CATHODE

安積隆夫^{#, A, B, C)}, 稲垣隆宏^{A, B)}, 大竹雄次^{B)}, 谷内努^{B)}, 西森信行^{C)}, 馬込保^{A, B, C)}, 柳田謙一^{B)}, 田中均^{A, C)}

Takao Asaka^{#, A, B, C)}, Takahiro Inagaki^{B, C)}, Yuji Otake^{B)}, Tsutomu Taniuchi^{B)}, Nobuyuki Nishimori^{A)},

Tamotsu Magome^{A, B, C)}, Kenichi Yanagida^{B)}, Hitoshi Tanaka^{A, C)}

^{A)} RIKEN SPring-8 Center (RSC)

^{B)} Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI)

⁽¹⁾ National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST)

Abstract

The 3-GeV linear accelerator for a soft x-ray free-electron lasers (SX-FEL) requires an electron gun capable of delivering highly stable and bright electron beam. A new low-emittance gridded thermionic gun embedded in a 238-MHz rf cavity has been developed for this purpose. The 238-MHz rf cavity accelerates the electron beam generated from the 50-kV thermionic-gun up to 500 keV to avoid emittance dilution due to space charge effect at low energy. We built a gun test stand to verify the high beam performance, i.e., a normalized emittance of less than 4 mm mrad with a bunch charge of 1 nC, as predicated by CST and PARMELA codes. Our proof-of-performance experiments demonstrated that a projection emittance of 1.7 mm mrad was obtained as a core part, representing 60% of all extracted electrons. This measured emittance agreed well with the simulation value of 2.0 mm mrad.

1. はじめに

次世代放射光施設[1]は、2023 年の利用運転を目指 し、現在、建屋建設、ならびに加速器構成機器の製 作が進められている。高輝度蓄積リングへの入射用 3 GeV 線型加速器は全長 110 m で、低エミッタンス 電子銃を備えた入射部と 20 台の高電界 C バンドユ ニットから構成される。3 GeV 線型加速器は、蓄積 リングへの入射以外に、軟 X 線自由電子レーザー (SX-FEL) への拡張を計画している。全長 25 m の アンジュレータを線型加速器の後方に設置した場合、 SX-FEL 発振に要求されるピーク電流は 3 kA で規格 化スライスエミッタンスは 2 mm mrad である[2]。

アパーチャの狭い高輝度リングへの入射やSX-FEL の効率的な運転のためには、低エミッタンス電子 ビームの生成が必要であり、これまで大規模なレー ザシステムを備えた光陰極型 RF 電子銃や 500 kV 熱 電子銃[3]が使われてきた。このうち、500 kV 熱電子 銃は、カソード寿命や安定性の点で優れているが、 500 kV の高電圧パルス発生のための大型電源や 1ns ビームパルス切出しのための高速ビームチョッパー を備えなければならないのが、小、中規模施設に とっては大きな負担である[4]。

こうした点を踏まえ、省コストでかつ保守性に優れた 500 keV 低エミッタンス電子銃システムを新た に開発した[5]。本電子銃は、50 kV の印加電圧で駆 動する熱電子銃と 238 MHz 高周波空胴で構成される。 電子銃カソードには市販のグリッド付き熱カソード が装着され、600 ps 幅の電子パルスを生成し、直後 に設置した238 MHz 高周波空胴にて加速することで 500 keV の電子ビームを生成する。

多くの加速器施設で使用されているグリッド付き 熱カソードは、高堅牢性、長寿命、高安定といった 優位性をもっている。また、カソード・グリッド間 の電圧制御により 1 ns 以下のパルスビームが容易に 生成できる。しかしながら、グリッド付き熱カソー ドで生成されるビームは、グリッド近傍で生じる電 場歪み(レンズ効果)とビーム自身の空間電荷効果 により、エミッタンスは10 mm mrad 以上となり、低 エミッタンス電子銃としては不向きとされてきた。

我々は、グリッド近傍のレンズ効果によるエミッ タンス悪化が、グリッド・カソード間のパルス電圧 に依存し、電圧調整することで平行ビーム生成が可 能であることに着目した。このグリッド透明化条件 では、規格化エミッタンスは1 mm mrad 程度の一様 分布ビームを生成できる。この条件下で生成された 低エミッタンスビームは、238 MHz 高周波空胴で 500 keV まで加速することにより、空間電荷効果に よるエミッタンス増大を回避することができる。

以上の低エミッタンスビーム生成スキームについ て、粒子トラッキングシミュレーションを行い、2 mm mrad/0.6 nC の低エミッタンスビームが生成可能 であることを確認した。これを実証するため、計算 結果に基づく電子銃システムの製作、およびビーム 性能評価のための診断装置を構築し、ビーム生成試 験を実施した[5]。本報告では、ビーム性能評価試験 結果、とくにスリットスキャン法によるエミッタン ス測定結果について報告する。

[#] asaka@spring8.or.jp

Proceedings of the 17th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan September 2 - 4, 2020, Online

2. 電子銃システム

次世代放射光施設では、長期間に渡って安定な運 転を行う必要があるため、本電子銃システムの構成 機器は、技術的に確立され、実績のある要素技術を 使用する。熱カソードは、入手が容易である市販の グリッド付き熱カソード(EIMAC Y-845, CPI 社製) を採用する。グリッド・カソード間には、高速パル ス電圧を印加して、600 ps 幅の電子パルスビームを 生成する。高電圧電源のコスト削減と小型化のため、 アノード・カソード間電圧は 50 kV と比較的低い電 圧設定とする。この場合、電子銃から生成される ビームは、ドリフトスペースで空間電荷効果による エミッタンス悪化が懸念される。これを回避するた め、電子銃出口(アノード電極出口)から 238 MHz 高周波空胴の加速ギャップまでの距離はできる限り 短くなるよう設計した。空胴のシャントインピーダ ンスを上げるためにノーズを設けると、ドリフトス ペースは 200 mm となる。この区間のビーム輸送に おいて、横方向の電子分布均一性を維持するために、 磁気レンズを電子銃と空胴との間に挿入した。これ によりビーム発散を抑え、非線形性空間電荷効果に よるエミッタンス増大を回避できる(Figure 1)。

電子銃の 50 kV 高電圧パルスを発生させるため、 耐電圧が 13 kV の SiC-MOSFET を用いたマルクス電 源[6]を使用する。また、238 MHz 高周波空胴へ供給 する RF 電力は最大 1.5 kW 出力の LD-MOSFET デバ イスを使用した 42 kW パルス高周波増幅器[7]を用い る。これらは保守性に優れているだけでなく信頼性 の向上、さらに省コスト化にも貢献する。

3. ビーム評価試験

3.1 電子銃テストスタンドの構成

電子銃システムの性能評価のため、Fig. 2 に示す ビーム診断装置を構築した。238 MHz 高周波空胴の 後方には、壁電流モニタ(WCM)、ビームコリ メータ(COL)、スリット(SL)、スクリーンモニ タ(SCM)、ファラデーカップ(FC)が装備される。 エネルギープロファイルを観測するために 30°偏向 電磁石とその後方にスクリーンモニタを設置した。



Figure 1: Schematic drawing of the low-emittance gridded thermionic electron gun embedded in the 238-MHz rf cavity. Shunt impedance of the 238-MHz rf cavity is 6.17 M Ω .

スクリーンモニタの蛍光板には、帯電防止のため の金蒸着を施した厚さ100µmのYAG:Ceシンチレー タを使用している。また、±25 mmの視野範囲にお いて、画像歪みなくビームプロファイルを観測可能 となるように、CCD カメラにはテレセントリックレ ンズを装着する。

3.2 ビームプロファイル

電子銃のグリッド電圧は、シミュレーションで得 られたグリッド透明化条件を設定する。また、磁気 レンズ励磁量、および 238 MHz 高周波空胴の RF 電 力・位相もシミュレーション結果を反映する。ビー ムエネルギーは、2 台の壁電流モニタから得られる 信号の時間差からエネルギーを算出する。また、30° 偏向電磁石後のスクリーンモニターでエネルギープ ロファイルを観測し、エネルギー幅が最小となるよ うに 238 MHz 高周波空胴の位相が微調整される。

以上の調整後、ビーム電荷量とビームエネルギー は、設計値と概ね一致する結果を得た。電荷量が1 nC でエネルギーが500 keV のビームについて、238 MHz 高周波空胴の後方に設置されたスクリーンモ ニタで観測される典型的なビームプロファイルを Fig. 3 に示す。ビームコア部の横方向強度分布にお いて、一様性を保持していることが分かる。



Figure 2: Layout of the gun test stand. The symbols ML, ST, WCM, FC, SCM, EPM, and BM represent a magnetic lens, a steering coil, a beam collimator, a beam slit, a wall current monitor, a Faraday cup, a screen monitor, an energy profile monitor, and a 30° bending magnet, respectively.

PASJ2020 THPP51



Figure 3: Beam profile image of 500 keV, 1 nC beam on the YAG:Ce screen.

3.3 エミッタンス測定

スリットスキャン法により 238 MHz 高周波空胴で 500 keV に加速された後の電子ビームのエミッタン スを測定した。238 MHz 高周波空胴のギャップから 1.2 m 下流に設置した可動スリットにより、0.1 mm 幅でビームが切り出される。この切り出されたビー ムは、さらに 474 mm 後方のスクリーンモニタにて、 ビームの角度発散分布画像を取得する。スリット位 置を変えて画像取得し、これを x-x'位相空間分布に 再構成した結果を Fig. 4 に示す。スキャン範囲は 20 mm、スリット可動ステップは 0.25 mm である。

ノイズ除去、ならびにビームコア部分のエミッタ ンスを評価するため、ビーム分布の 90%、60%、ガ ウシアンフィッティングによる解析をおこなった。 その結果、規格化エミッタンスは 4.3 mm mrad (90% core part)、1.7 mm mrad (60% core part)、3.1 mm mrad (Gaussian fitting)であった。シミュレーションで予測 された規格化エミッタンスは 3.3 mm mrad (100%)、 2 mm mrad (60%)であり、とくにビームコア部分にお いては、概ね一致している。本測定で得られたビー ムパラメータを Table 1 にまとめる。



Figure 4: Phase-space of the 500 keV, 1 nC beam.

Table 1: Beam Parameters at the Exit of the Electron Gun System

Charge	1 nC
Energy	500 keV
Energy spread	4.2 % (60% core part)
Norm. emittance (rms)	4.3 mm mrad (90 % core part)
Norm. emittance (rms)	1.7 mm mrad (60 % core part)
Norm. emittance (rms)	3.1 mm mrad (Gaussian fit)

4. まとめ

市販のグリッド付き熱カソードを用いた低エミッ タンス電子銃システムを製作し、性能評価試験を実 施した。電子銃システムから出力される 500 keV ビームに対して、スリットスキャン法によるエミッ タンス測定を行った結果、規格化エミッタンスが1.7 mm mrad (60% core part)となり、設計性能を満たして いることを確認した。

これまで、グリッド付き熱カソードはグリッド近 傍のレンズ効果によるエミッタンスへの影響から、 低エミッタンス電子銃として不向きとされてきた。 しかしながら、グリッド透明化条件を与えるウェネ ルト、アノード電極形状、電場強度の最適化により、 低エミッタンスビーム生成が可能となることを実証 した。

3 GeV 線型加速器の入射部では、本電子銃システ ムから生成される 500 keV 低エミッタンスビームを 476 MHz サブハーモニックバンチャーでバンチ圧縮 後、可変式コリメータでビームコア部を切り出すこ とによりビーム電荷量を調整する。今後、入射部を 構築し、電子集群、加速試験をおこなう予定である。

参考文献

- N. Nishimori *et al.*, "Accelerator system of high brilliant 3GeV light source project", in proc. of the 16th Annual Meeting of PASJ, Kyoto, Japan, July 31 -August 3, 2019, pp. 153-156.
- [2] T. Asaka *et al.*, "Basic design 3-GeV linear accelerator for a next-generation SR source", in proc. of the 16th Annual Meeting of PASJ, Kyoto, Japan, July 31 -August 3, 2019, pp. 771-775.
- [3] K. Togawa *et al.*, "CeB₆ electron gun for low-emittance injector", Phys. Rev. ST Accel. Beams **10**, 020703 (2007).
- [4] T. Asaka *et al.*, "Low-emittance thermionic-gun-based injector for compact free-electron laser", Phys. Rev. Accel. Beams **20**, 080702 (2017).
- [5] T. Asaka *et al.*, "Low-emittance radio-frequency electron gun using a gridded thermionic cathode", Phys. Rev. Accel. Beams 23, 063401 (2020).
- [6] C. Kondo *et al.*, "Development of 50 kV pulse generator using high voltage SiC-MOSFET for electron gun", in proc. of the 16th Annual Meeting of PASJ, Kyoto, Japan, July 31 -August 3, 2019, pp. 679-682.
- [7] S. Fukuoka *et al.*, "Development of 238-MHz 42-kW solidstate pulse RF amplifier", in proc. of the 16th Annual Meeting of PASJ, Kyoto, Japan, July 31 -August 3, 2019, pp. 283-287.